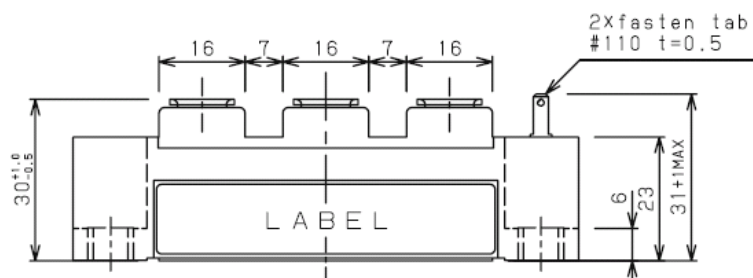
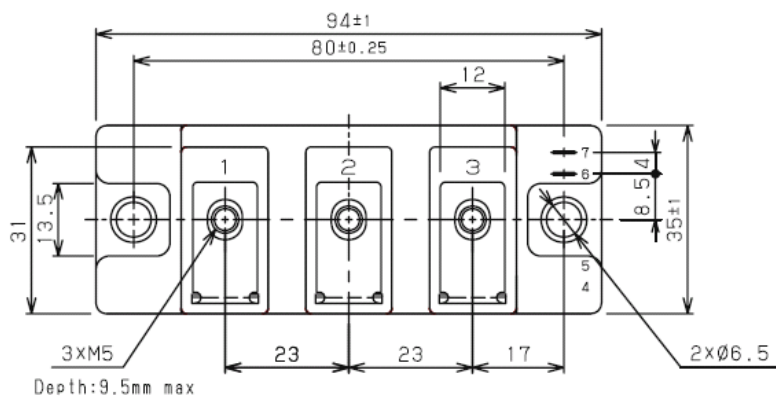
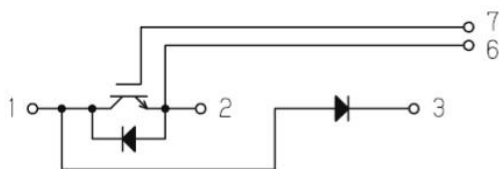


□ 回路図 : **CIRCUIT**

 □ 概略図 : **SCHEMATIC DIAGRAM**

Dimension: [mm]


 □ 最大定格 : **MAXIMUM RATINGS** (at Tc=25°C unless otherwise specified)

Item		Symbol	Condition	Rated Value	Unit
IGBT	コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	V <sub>CES</sub>	G-E Short	1200	V
	ゲート・エミッタ間電圧 Gate-Emitter Voltage	V <sub>GES</sub>	C-E Short	±20	V
	コレクタ電流 Collector Current	I <sub>C</sub>	DC T <sub>c</sub> =85°C	50	A
		I <sub>CP</sub>	Pulse ≤ 1ms	100	
コレクタ損失 Collector Power Dissipation	P <sub>C</sub>	T <sub>j</sub> =175°C	277	W	
		T <sub>j</sub> =150°C	231		
FWD	繰り返しピーク逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	V <sub>RRM</sub>		1200	V
	順電流 Forward Current	I <sub>F</sub>		50	A
		I <sub>FM</sub>	Pulse ≤ 1ms	100	
最大接合温度 Maximum Junction Temperature		T <sub>jMAX</sub>	瞬時動作(過負荷) Instantaneous Overload	175	°C
接合温度範囲 Junction Temperature Range		T <sub>j</sub>		-40~+150	°C
保存温度範囲 Storage Temperature Range		T <sub>stg</sub>		-40~+125	°C
絶縁耐圧 Isolation Voltage		V <sub>ISO</sub>	Terminal to Base AC, 1minute	2,500	V (RMS)
締め付けトルク Mounting Torque	Module Base to Heatsink	F <sub>tor</sub>	M6	3	N · m
	Busbar to Main Terminal		M5	2	

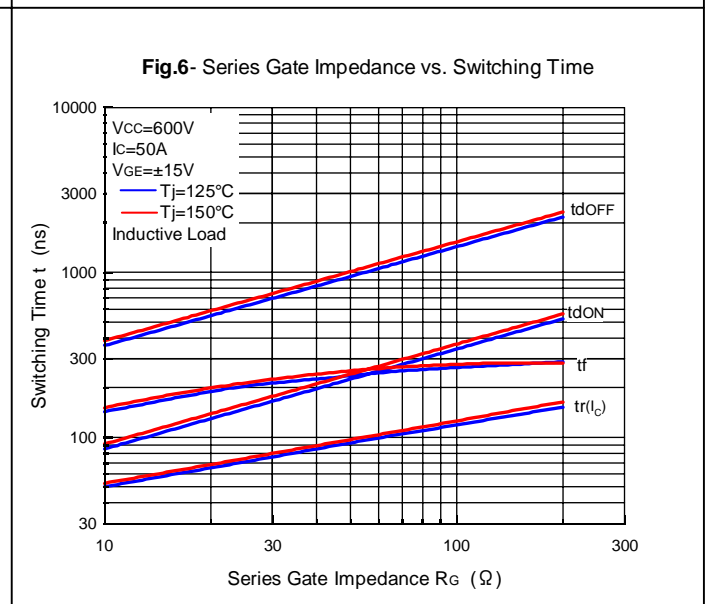
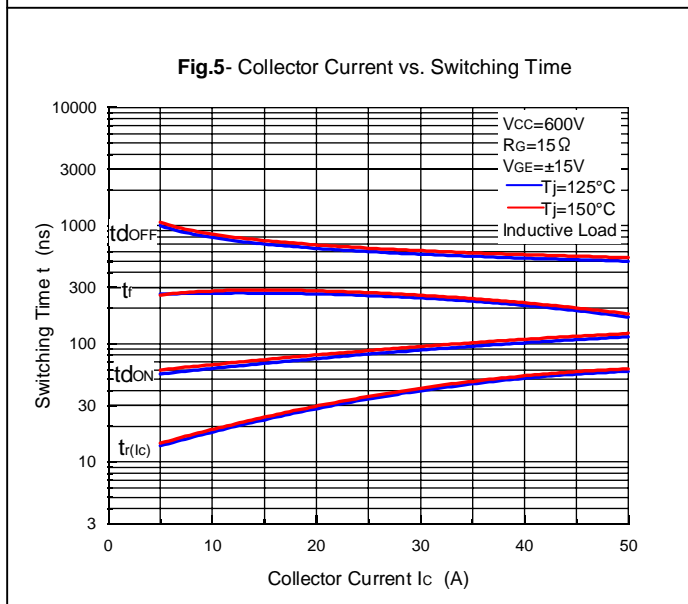
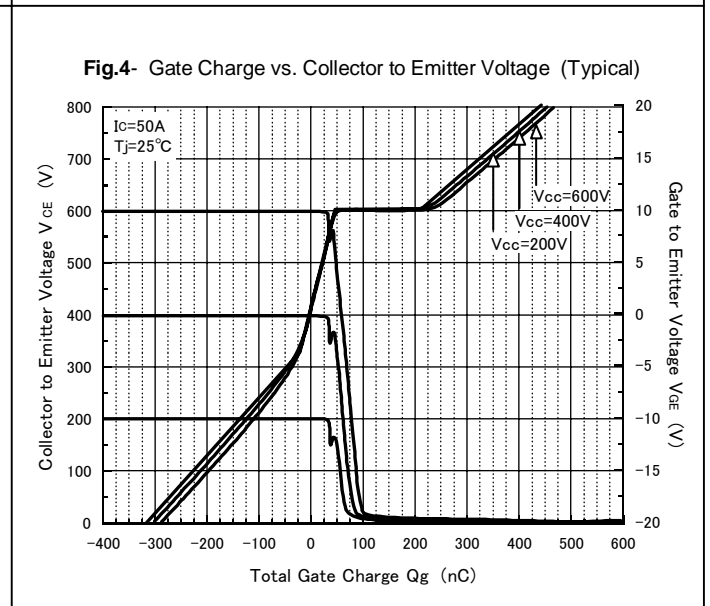
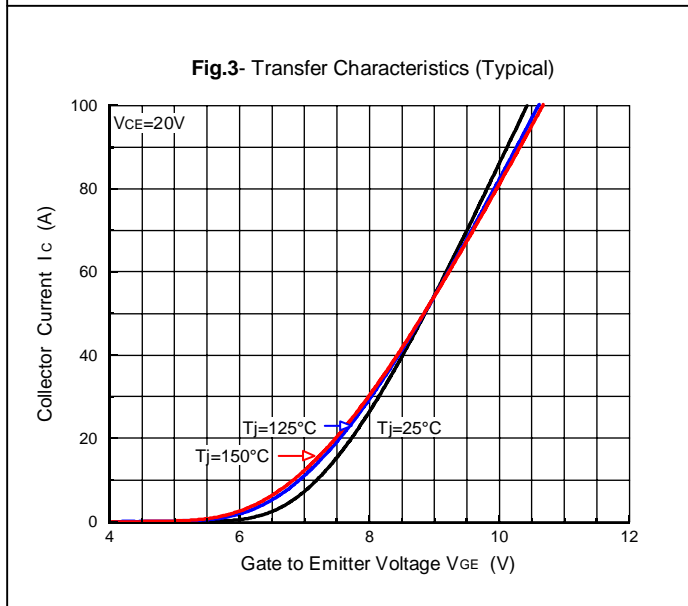
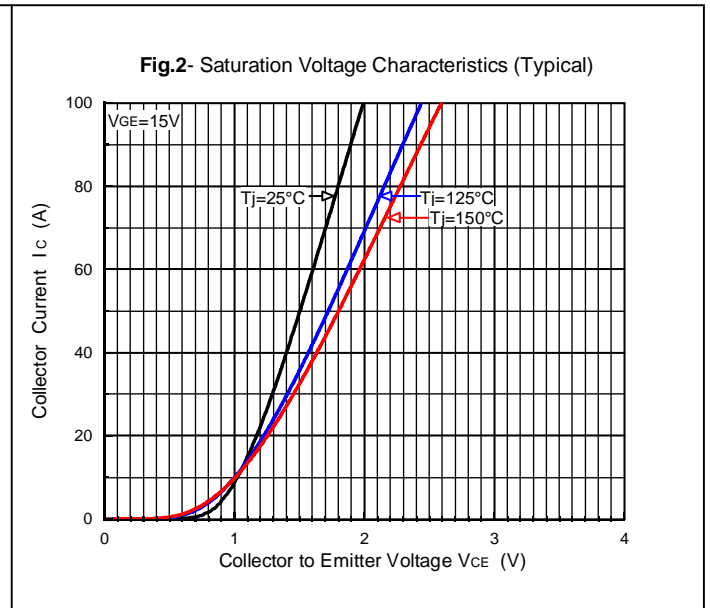
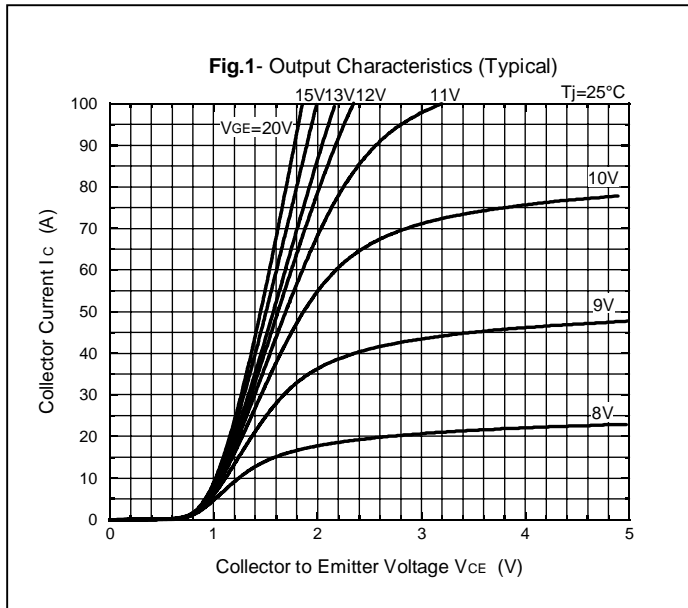
□ 電 氣 的 特 性 : **ELECTRICAL CHARACTERISTICS** (at  $T_j=25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified)

Characteristic		Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit	
IGBT	コレクタ遮断電流 Collector-Emitter Cut-Off Current	ICES	$V_{CE}=1200V, V_{GE}=0V$	—	—	1.0	mA	
	ゲート漏れ電流 Gate-Emitter Leakage Current	IGES	$V_{GE}=\pm 20V, V_{CE}=0V$	—	—	1.0	$\mu\text{A}$	
	コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-Emitter Saturation Voltage	VCE(sat.)	$I_c=50A, V_{GE}=15V$ (chip level)	$T_j=25^\circ\text{C}$	—	1.50	2.00	V
				$T_j=125^\circ\text{C}$	—	1.70	—	
				$T_j=150^\circ\text{C}$	—	1.80	—	
	ゲートしきい値電圧 Gate-Emitter Threshold Voltage	VGE(th.)	$V_{CE}=10V, I_c=1.7mA$	4.8	—	7.0	V	
	入力容量 Input Capacitance	Cies	$V_{CE}=25V, V_{GE}=0V, f=1MHz$	—	5.3	—	nF	
	出力容量 Output Capacitance	Coes		—	0.16	—		
	帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	Cres		—	0.12	—		
	ゲート電荷量 Gate Charge	Qg	$V_{CC}=600V, I_c=50A, V_{GE}=-15\sim+15V$	—	550	—	nC	
スイッチング時間 Switching Time	上昇時間 Rise Time	tr	$V_{CC}=600V, L_s=38nH$ $I_c=50A$ Inductive Load $R_g=15\Omega$ $V_{GE}=\pm 15V$ $T_j=150^\circ\text{C}$	—	60	—	ns	
	ターンオン遅延時間 Turn-on Delay Time	td(on)		—	110	—		
	下降時間 Fall Time	tf		—	180	—		
	ターンオフ遅延時間 Turn-off Delay Time	td(off)		—	500	—		
順電圧 Peak Forward Voltage	VF	$I_F=50A, V_{GE}=0V$ (chip level)	$T_j=25^\circ\text{C}$	—	2.00	2.60	V	
			$T_j=125^\circ\text{C}$	—	1.98	—		
			$T_j=150^\circ\text{C}$	—	1.95	—		
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	$V_{CC}=600V, L_s=38nH$ $I_c=50A$ Inductive Load $R_g=15\Omega$ $V_{GE}=\pm 15V$ $T_j=150^\circ\text{C}$	—	130	—	ns		
内部配線抵抗 Internal Lead Resistance	RCC+EE'	主端子—チップ間 / 1素子 Main Terminal - Chip / Per 1 Arm	—	—	1	m $\Omega$		
内部インダクタンス Stray Inductance	LSCE	メイン端子3—2間 Main Terminal 3 - Main Terminal 2	—	30	—	nH		

 □ 熱 的 特 性 : **THERMAL CHARACTERISTICS**

Characteristic		Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
熱抵抗 Thermal Resistance	IGBT	Rth(j-c)	Junction to Case Per 1 Arm (Tc測定点:チップ直下)	—	—	0.54	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	FWD			—	—	0.97	
接触熱抵抗 Thermal Resistance	IGBT	Rth(c-f)	Case to heatsink Per 1 Arm Paste=1W/(m $^2$ °C)	—	0.10	—	
	FWD			—	0.17	—	

特性图 : CHARACTERISTICS CURVES



特性 : CHARACTERISTICS CURVES

